

양극 산화에 의한 다공성 알루미늄 막의 제조 및 특성 분석

최지영, 조성민*

성균관대학교

(smcho@skku.ac.kr*)

본 연구에서는 Si wafer(100)을 기판으로 하여, thermal evaporator를 이용하여 Al 을 증착한 뒤 양극 산화법에 의해 다공성 알루미늄 막을 만들었다. 이 때 양극 산화시간과 구멍 넓힘 시간을 달리하였다. 제작된 다공성 알루미늄 막은 SEM, AFM 및 reflectance interference spectroscopy 분석을 하였다.